ций, поэтому исследование процессов изменения в составе, связанных с временным фактором, изменением температуры окружающей среды, целесообразно проводить в натурных условиях.

- 4. Полученные данные позволяют судить об эффективной работе цеолитового фильтра:
 - за время эксперимента (свыше 800 ч) адсорбционные свойства цеолита практически не изменились;
 - значение давления после устройства оставалось в пределах нормы, т. е. не превышало 15 % от рабочего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Танатаров М.А., Ахмедшина М.Н., Фасхутдинов Р.А. и др. Технологические расчеты установок переработки нефти. – М.: Химия, 1987. – 352 с.
- Гриценко А.И., Александров И.А., Галанин И.А. Физические методы переработки и использования газа. – М.: Недра, 1981. – 224 с.
- Мурина В.И. Технология переработки природного газа и конденсата: Справочник. В 2 ч., Ч. 1. – М.: Недра, 2002. – 194 с.

- Полученная в результате эксперимента зависимость перепада давления от времени работы фильтрующего элемента в условиях межсезонья позволяет спрогнозировать ситуацию поведения цеолита в заданных условиях:
 - время насыщения цеолита без регенерации до достижения максимального перепада давления составляет 10,6 ч;
 - максимальное значение числа регенераций для поддержания оптимального значения перепада давления до и после адсорбционного устройства порядка 100 раз.
- 4. Ильина М.Н. Требования к подготовке попутного нефтяного газа для малой энергетики // Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310. № 2. С. 167–171.
- Спейшер В.А., Горбаненко А.Д. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 183 с.

Поступила 06.10.2008 г.

УДК 538.56:538.542.001.24

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАССИВНЫХ ПРОВОДНИКОВ

Г.В. Носов

Томский политехнический университет E-mail: nosov@elti.tpu.ru

Получены формулы для расчета эквивалентных импульсных параметров массивных проводников с учетом адиабатного нагрева и нелинейных магнитных свойств поверхностного слоя при диффузии плоской одномерной электромагнитной волны в проводящее полупространство. Эквивалентные параметры (толщина и температура поверхностного слоя, давление магнитного поля и мощность тепловых потерь, сопротивление и индуктивность) принимаются усредненными и постоянными во время действия импульса напряженности магнитного поля на поверхности проводника. Форма этого импульса приближенно учитывается его длительностью, среднеквадратичным значением и числом положительных и отрицательных полуволн. Нелинейные магнитные свойства ферромагнитного проводника учитываются степенной зависимостью для его кривой намагничивания. Достоверность полученных формул подтверждается рассмотрением частых случаев для неферромагнитных проводников и рассчитанными зависимостями для магнитной проницаемости конструкционной стали.

Ключевые слова:

Эквивалентные импульсные параметры, массивные проводники, ферромагнитные проводники, поверхностный слой, скин-эффект, магнитное поле, магнитная проницаемость, кривая намагничивания, плоская электромагнитная волна.

При проектировании и оптимизации многих электрофизических устройств, работающих в импульсном режиме, возникает необходимость расчета их параметров с учетом проникновения (диффузии) электромагнитного поля (ЭМП) в массивные проводники. Такими проводниками могут быть электромагнитные экраны, обмотки и роторы электромашинных генераторов, а также нагреваемые детали в устройствах индукционного нагрева. В настоящее время при расчете диффузии ЭМП широкое применение получили численные методы прямого решения на ЭВМ уравнений электродинамики. Однако такое решение приводит к чрезмерно большим затратам машинного времени и во многих случаях затрудняет анализ влияния различных импульсов ЭМП на такие параметры проводников как сопротивление, индуктивность, глубина проникновения ЭМП в проводник, температура и давление магнитного поля [1]. Исследования электрофизических устройств при наличии поверхностного эффекта в проводниках существенно упрощаются с использованием эквивалентных параметров поверхностного слоя (скин-слоя) проводников [1–4]. Расчет импульсных параметров массивных проводников при диффузии в них различных по форме импульсов ЭМП с учетом нагрева и нелинейных магнитных свойств скин-слоя попрежнему представляется актуальной задачей.

Цель данной работы заключается в получении приемлемой для инженерных расчетов методики определения эквивалентных импульсных параметров массивных проводников. Для этого сделаем следующие допущения.

- Размеры массивных проводников существенно превосходят глубину проникновения в них ЭМП, поэтому будем исходить из представления о плоской одномерной электромагнитной волне, проникающей в проводник перпендикулярно его поверхности и полностью затухающей в его теле [5–7].
- Эквивалентная глубина проникновения ЭМП в массивный проводник ∆ принята постоянной и определяется физическими свойствами материала проводника.



Рис. 1. Распределение действующих значений напряженностей плоской одномерной электромагнитной волны в проводящем полупространстве

- В поверхностном слое проводника при 0≤z≤∆ плоская одномерная электромагнитная волна характеризуется среднеквадратичными (действующими) значениями (рис. 1):
 - напряженности магнитного поля

$$H_{y}(z) = H \cdot \left[1 - \frac{z}{\Delta}\right], \tag{1}$$

где действующее значение напряженности на поверхности проводника

$$H = \sqrt{\frac{1}{\tau} \cdot \int_{0}^{\tau} [H_{S}(t)]^{2} dt}$$

причем $H_{s}(t)$ — заданная напряженность магнитного поля на поверхности проводника как функция времени;

• индукции магнитного поля

$$B_{\nu}(z) = M \cdot H_{\nu}(z)^{\nu/n}, \qquad (2)$$

где M и n – постоянные в первом приближении параметры проницаемости и степени кривой намагничивания ферромагнитного проводника [6], причем для любого неферромагнитного проводника $M=\mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}$ Гн/м и n=1; • напряженности электрического поля [7]

$$E_x(z) = -\frac{1}{\gamma} \cdot \frac{d[H_y(z)]}{dz} = \frac{H}{\gamma \cdot \Delta},$$
(3)

где γ – постоянная удельная проводимость проводника (1/Ом·м);

• плотности тока [7]

$$\delta_x(z) = \gamma \cdot E_x(z) = \frac{H}{\Delta}.$$
(4)

4. Вне поверхностного слоя проводника при *z*>∆ ЭМП отсутствует:

$$H_{v}(z) = 0; B_{v}(z) = 0; E_{x}(z) = 0; \delta_{x}(z) = 0.$$

- Длительность импульса τ ЭМП достаточно мала, поэтому нагрев поверхностного слоя проводника при 0≤*z*≤Δ происходит адиабатно (без учета теплоотдачи в окружающую среду) и за счет равномерной и постоянной плотности тока (4) усредненная температура этого слоя θ также равномерна и постоянна.
- При любой температуре θ поверхностный слой проводника при 0≤z≤Δ характеризуется постоянными значениями удельной теплоемкости C₁, Дж/(кг·°С) и удельной плотности ρ, кг/м³, проводника, а удельная проводимость этого слоя зависит от температуры как [8]:

$$\gamma = \frac{\gamma_0}{1 + \alpha_T [\theta - \theta_0] + \beta_T [\theta - \theta_0]^2},$$
(5)

где γ_0 – удельная проводимость при температуре θ_0 , которая была до воздействия импульса ЭМП; α_T и β_T – постоянные температурные коэффициенты сопротивления проводника.

В результате для поверхностного слоя на основании формул (1–3) находим среднюю мощность тепловых потерь [7]

$$P = l_x l_y \int_0^{\Delta} \gamma E_x(z)^2 dz = \frac{H^2}{\gamma \cdot \Delta} l_x l_y, \qquad (6)$$

усредненную энергию магнитного поля

$$W = l_{x}l_{y}\int_{0}^{n} [H_{y}(z) \cdot dB_{y}(z)]dz =$$

= $\frac{nM}{(1+n)(1+2n)}l_{x}l_{y} \cdot \Delta \cdot H^{(1+n)/n}$ (7)

и усредненный магнитный поток

$$\Phi = l_x \int_0^{\Delta} B_y(z) dz = \frac{nM}{(1+n)} l_x \cdot \Delta \cdot H^{1/n}, \qquad (8)$$

где l_x и l_y – размеры проводника по координатам *x* и *y* соответственно (рис. 1).

Для определения эквивалентной глубины проникновения ЭМП в проводник (толщины поверхностного слоя) Δ воспользуемся законом электромагнитной индукции [7]

$$e(t) = \oint \overline{Edl} = -\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

тогда для действующих значений приближенно гармонических функций ЭДС e(t) и магнитного потока $\Phi(t)$ имеем

$$-E_{x}(0)\cdot l_{x}+E_{x}(z)\cdot l_{x}\approx -\omega\Phi,$$
(9)

где $\omega = \pi m / \tau$ — расчетная угловая частота импульса ЭМП; *m* — число положительных и отрицательных полуволн в импульсе *H_s*(*t*), причем для прямоугольного видеоимпульса и для импульса в виде одной полуволны синусоиды принимаем *m*=1.

В результате при $z \ge \Delta$ и $E_x(z) = 0$ с учетом (3,8,9) получаем

$$\Delta \approx \sqrt{\frac{(1+n)\tau}{\pi m n M \gamma}} \cdot H^{(n-1)/n} = \sqrt{\frac{(1+n)}{n M \gamma \omega}} \cdot H^{(n-1)/n} .$$
(10)

Достоверность формулы (10) подтверждается тем, что для неферромагнитного проводника при $M=\mu_0$ и n=1 формула (10) дает известную эквивалентную толщину поверхностного слоя для установившегося гармонического ЭМП [5]

$$\Delta \approx \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}},\tag{11}$$

позволяет приближенно рассчитать при m=1 известную глубину диффузии прямоугольного видеоимпульса $H_s(t)$ [8]

$$\Delta \approx 0.8 \cdot \sqrt{\frac{\tau}{\mu_0 \gamma}} \approx \sqrt{\frac{\tau}{\mu_0 \gamma}}$$
(12)

и дает возможность определить приближенную эквивалентную толщину скин-слоя для радиоимпульса в виде нескольких полуволн синусоиды $H_{s}(t)$ [1]

$$\Delta \approx \sqrt{\frac{2\tau}{\pi m \mu_0 \gamma}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}} \cdot \sqrt{\frac{\omega \tau}{\pi m}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}.$$
 (13)

Из уравнения адиабатного процесса нагрева [9]

$$\delta_x(z)^2 = \gamma C_T \rho \frac{d\theta}{dt} \approx \gamma C_T \rho \frac{\theta - \theta_0}{\tau},$$

с учетом (10) определяем усредненную температуру скин-слоя

$$\theta \approx \theta_0 + \frac{\delta_x(z)^2 \tau}{\gamma C_T \rho} =$$
$$= \theta_0 + \frac{H^2 \tau}{\gamma C_T \rho \Delta^2} \approx \theta_0 + \frac{\pi m n M}{(1+n)C_T \rho} \cdot H^{(1+n)/n}.$$
(14)

Усредненное давление магнитного поля с индукцией (2) на поверхностный слой с плотностью тока (4) можно рассчитать следующим образом [10]

$$\sigma = \int_{0}^{\Lambda} [\delta_x(z) \cdot B_y(z)] dz = \frac{nM}{(1+n)} \cdot H^{(1+n)/n}.$$
 (15)

Сопротивление R и индуктивность L массивного проводника найдем с учетом (6) и (7) из уравнений для действующего значения тока

$$I = l_y \cdot \int_0^{\Delta} \delta_x(z) dz = l_y \cdot H,$$

средней мощности тепловых потерь

 $P = I^2 \cdot R$

и усредненной энергии магнитного поля

$$W = \frac{1}{2}I^2 \cdot L.$$

В результате получаем сопротивление

$$R = \frac{l_x}{l_y \gamma \Delta} \tag{16}$$

и индуктивность массивного проводника для внутреннего магнитного поля

$$L = \frac{2nM}{(1+n)(1+2n)} \cdot \frac{l_x}{l_y} \Delta \cdot H^{(1-n)/n}.$$
 (17)

Если для кривой намагничивания ферромагнитного проводника заданы значения напряженности H_1 , H_2 и известны соответствующие им значения индукции B_1 и B_2 , то тогда можно рассчитать используемые в выше приведенных формулах параметры степени

$$n = \frac{\ln(H_2/H_1)}{\ln(B_2/B_1)} \tag{18}$$

и проницаемости

$$M = \frac{B_1}{H_1^{1/n}}.$$
 (19)

Так, например, для конструкционных ферромагнитных сталей с усредненной кривой намагничивания (рис. 2), параметры, рассчитанные по (18) и (19) при $H_2 > H_1$ и изменении напряженности *H* от 10² до 5·10⁶ А/м, принимают значения *n*=0,5...12,4 (рис. 3) и *M*=2·10⁻⁵...0,844 (рис. 4). Таким образом, параметры *n* и *M* кривой намагничивания необходимо подставлять в формулы (10, 14, 15, 17) как функции *H* (рис. 2).

На рис. 5–9 приведены расчетные зависимости для радиоимпульса при τ =0,5 с, m=50, ω =314 p/c, полученные по (10, 13–15, 6) для меди θ_0 =20 °C; γ_0 =5·10⁷ 1/(Ом·м); α_7 =4,2·10⁻³ 1/°C; β_T =0,453·10⁻⁶ 1/°C²; ρ =8900 кг/м³; C_T =385,5 Дж/(кг°C) и конструкционной ферромагнитной стали θ_0 =20 °C; γ_0 =5·10⁶ 1/(Ом·м); α_T =5,5·10⁻³ 1/°C; β_T =9·10⁻⁶ 1/°C²; ρ =7850 кг/м³; C_T =575 Дж/(кг°C) с использованием найденных параметров *n*, *M* (рис. 3, 4).



Рис. 2. Усредненная кривая намагничивания конструкционных сталей: «•••» – заданные значения из [6]; «——» – расчетная зависимость B=M·H^{1/n}



Рис. 3. Зависимость безразмерного параметра степени усредненной кривой намагничивания конструкционных сталей от действующего значения напряженности на поверхности сталей



Рис. 4. Зависимость параметра проницаемости усредненной кривой намагничивания конструкционных сталей от напряженности, размерность – (Гн·м)·(A/м)^{(n-1)/n}



Рис. 5. Зависимости эквивалентной толщины поверхностного слоя от напряженности: 1) конструкционная сталь; 2) медь

Таким образом, полученные формулы могут использоваться для расчета эквивалентных импульсных параметров массивных ферромагнитных и неферромагнитных проводников при воздействии на них импульсного ЭМП. На основании анализа формул и проведенных расчетов можно сформулировать следующие выводы.

1. С увеличением числа положительных и отрицательных полуволн *m* в импульсе напряженности магнитного поля на поверхности проводника $H_s(t)$ эквивалентная толщина скин-слоя Δ уменьшается, а температура этого слоя θ возрастает, причем на эту температуру не влияет удельная проводимость γ .

2. С увеличением действующего значения H напряженности $H_s(t)$ для неферромагнитного проводника величины θ и Δ возрастают особенно заметно при $H>10^6$ А/м.







Рис. 7. Зависимости давления магнитного поля от напряженности: 1) конструкционная сталь; 2) медь



Рис. 8. Зависимости удельной средней мощности тепловых потерь от напряженности: 1) конструкционная сталь; 2) медь



Рис. 9. Зависимости относительной магнитной проницаемости конструкционной стали на поверхности (z=0) для действующих значений H от удельной средней мощности тепловых потерь: 1) расчет с учетом нагрева; 2) расчет без учета нагрева; 3) результат без учета нагрева для установившегося гармонического ЭМП из [6]

- За счет нелинейности кривой намагничивания ферромагнитного проводника с увеличением действующего значения напряженности *H* величина θ возрастает, а Δ – вначале уменьшается, а при *H*>10³ A/м – возрастает.
- 4. С увеличением действующего значения напряженности *Н* удельная средняя мощность тепло-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Петров С.Р. Расчет эквивалентных параметров скин-слоя с учетом джоулева нагрева // Электричество. – 1987. – № 6. – С. 61–63.
- 2. Носов Г.В., Эськов В.Д. К расчету эквивалентной глубины скин-слоя при импульсных токах // Электричество. 1990. № 6. С. 82–83.
- Носов Г.В. Эквивалентные параметры массивных проводников с учетом их нагрева при апериодических импульсных токах // Электротехника. – 1991. – № 10. – С. 42–44.
- Носов Г.В. Эквивалентные параметры массивных проводников с учетом их нагрева в установившемся режиме при периодических токах // Электричество. – 1992. – № 10. – С. 55–57.
- 5. Немков В.С., Демидович В.Б. Теория и расчет устройств индукционного нагрева. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 280 с.

вых потерь P и давление магнитного поля σ возрастают, причем для ферромагнитных проводников значения P и σ превышают соответствующие величины для неферромагнитных проводников.

- На эквивалентные параметры массивных проводников (Δ, θ, P, σ, сопротивление R, индуктивность L) влияет форма импульса напряженности H_s(t), которая приближенно учитывается длительностью импульса τ, величинами m и H, причем это влияние особенно заметно для ферромагнитных проводников.
- При воздействии на массивный проводник видеоимпульса H_s(t) при m=1 предельным значением можно считать H>1,77·10⁷ A/м (B=µ₀H>22 Tл), когда θ>200 °С и σ>1,97·10⁸ Па, т. е. тогда возможно разрушение проводника.
- Достоверность методики расчета подтверждается получением для неферромагнитных проводников, как для частных случаев, известных формул (11–13) и зависимостями для относительной магнитной проницаемости конструкционной стали (рис. 9), которые удовлетворительно совпадают с зависимостью из [6] и дают, что общеизвестно [6], магнитную проницаемость практически независящую от нагрева до температуры Кюри (~750 °C).
- Кувалдин А.Б. Индукционный нагрев ферромагнитной стали. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 200 с.
- Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Том 3. 4-е изд. / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 2003. – 377 с.
- 8. Туровский Я. Техническая электродинамика. М.: Энергия, 1974. 488 с.
- Теория электрических аппаратов / Под ред. Г.Н. Александрова. – М.: Высшая школа, 1985. – 312 с.
- Татур Т.А. Основы теории электромагнитного поля. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 1989. 271 с.

Поступила 18.09.2008 г.